光解水制氢半导体光催化材料的研究进展;

田蒙奎1,2,上官文峰2,欧阳自远1,王世杰1 (1. 中国科学院 地球化学研究所,贵州 贵阳 550002; 2. 上海交通大学 机械与动力学院燃烧与环境技术研究中心,上海 200030)

摘要: 自从Fujishima-Honda 效应发现以来,科学 研究者一直努力试图利用半导体光催化剂光分解水来 获得既可储存而又清洁的化学能——氢能。近一二十 年来,光催化材料的研究经历了从简单氧化物、复合氧 化物、层状化合物到能响应可见光的光催化材料。本 文重点描述了这些光催化材料的结构和光催化特性, 阐述了该课题的意义和今后的研究方向。 关键词: 光解水:氢能:半导体光催化剂 中图分类号: X13 文献标识码:A

文章编号:1001-9731(2005)10-1489-04

引 盲 1

在能源危机和环境问题的双重压力下,氢能因其 燃烧值高、储量丰富、无污染而成为最有希望替代现有 化石能源的清洁能源,因而氢能的开发成了能源领域 的研究热点。自从 Fujishima 和 Honda 于 1972 年发 现了 TiO2 光电化学能分解水产生 H2 和 O2 以来[1], 科学研究者为实现太阳能光解水制氢一直在作不懈的 努力。普遍接受的光解水制氢原理是:半导体光催化 剂在能量等于或大于其禁带宽度的光辐射时,电子从 最高电子占据分子轨道(HOMO,即价带)受激跃迁至 最低电子未占据分子轨道(LUMO,即导带),从而在价 带留下了光生空穴(h⁺),导带中引入了光生电子 (e⁻)。光生空穴和光生电子分别具有氧化和还原能 力。要实现太阳能光解水制氢和氧,光生电子的还原 能力必须能还原 H₂O 产生 H₂, 而光生空穴的氧化能 力必须能氧化 H₂O 产生 O₂,即半导体光催化剂的导 带底要在 H_2O/H_2 电位($E_0 = 0V, pH = 0$)的上面(导 带位置越高,电位越负,还原能力越强);而价带顶在 O₂/H₂O电位(E_{NHE}=+1.23V,pH=0)的下面(价带 位置越低,电位越正,氧化能力越强)。

近一二十年来, TiO2 以外的光催化剂的相继发 现,特别是能响应可见光的光催化材料的出现,使得光 解水制氢研究进入了非常活跃时期。本文就近期太阳 能光解水制氢研究进展中的半导体光催化材料作一综 述。

简单半导体氧化物,硫化物系光催化剂 2

目前广泛研究的简单化合物半导体材料的能带结 构如图1所示。





TiO₂ 光催化剂由于光照不发生光腐蚀、耐酸碱性 好、化学性质稳定、对生物无毒性、来源丰富等优点而 被广为利用。具有代表性的 P25 二氧化钛粉体材料几 乎是现在最成功的光催化剂之一。但 TiO2 能隙大 (3.2eV),由此决定了其只能响应波长<385nm 的仅 占太阳辐射4%左右的紫外光,对太阳能的利用率很 低,并且只有在担载 Pt 或 RuO2 等情况下才有明显的 制氢效果。在 TiO2 中 Pt 和 RuO2 等助催化剂的负载 加快了光生电子和空穴向表面的迁移,有效抑制光生 电子和空穴的复合,从而显著提高了光催化活性[2]。 同时,TiO₂的复合体系如 CdS-TiO₂、SnO₂-TiO₂、 WO3-TiO2等也被广泛研究。这些复合体系光催化性 能不是简单的机械叠加,而是通过能级的匹配使电子 空穴实现有效的分离。通常光生电子从带隙窄、并且 导带更低的半导体转移到 TiO2 中的导带中,而光生空 穴仍留在窄带隙的半导体中,从而实现电子空穴的分 离,提高了其量子效率。

CdS的带隙虽只有 2.4eV,能有效的利用可见光, 但由于存在如下光腐蚀,限制了其单独作为光催化剂 的应用。其光化学反应如下:

$$CdS + hv \longrightarrow h^+ + e^-$$
 (1)

$$h^+ + OH^- \longrightarrow \frac{1}{2}O_2 + H^+$$
 (2)

$$e^- + H^+ \longrightarrow \frac{1}{2} H_2$$
 (3)

基金项目:国家重点基础研究发展计划(973 计划)资助项目(2003CB214500)

收到初稿日期:2005-01-25 收到修改稿日期:2005-04-25 1489

通讯作者:上官文峰 作者简介:田蒙奎 (1978-),男,贵州翁安县人,中国科学院地球化学研究所和上海交通大学联合培养博士研究生,从事光 触媒材料及太阳能光解水制氢的研究。

(4)

30

村

科

$2h^+ + CdS \longrightarrow Cd^{2+} + S$

因此,往往通过加入诸如 Na₂ SO₃、Na₂ S 等牺牲剂 (正孔捕捉剂),使得产氢反应不断进行下去。同时,也 常通过将 CdS 同其它宽带隙的光催化剂复合来改变 光催化剂的能带结构和稳定性^[3]。

3 复合氧化物

3.1 d区具有 d^o 构型的复合氧化物

近来,研究者把目光投向了具有半导体性质的过 渡金属复合氧化物,试图寻求一些新型高效光解水制 氢材料。由于光催化现象首先发现于半导体 TiO2 中, 在复合金属氧化物中,人们首先对钛酸盐作了广泛的 研究。继钙钛矿型的 CaTiO₃^[4]、SrTiO₃^[5]、A₂TiO₁₃ (A=Na、K、Rb)^[6]、Na₂Ti₃O₇^[7]、K₂Ti₄O₉^[8]等光解水 特性被报道,同处于 d 区具有 d° 电子构型的铌酸盐 (Nb⁵⁺)、钽酸盐(Ta⁵⁺)体系也引起了一些研究者的 兴趣。其中 $A_4 Nb_6 O_{17} (A = K Rb)^{[9]} Sr_2 Nb_2 O_7^{[10]}$ 、 $ATaO_3$ (A = Na, K), MTa_2O_6 (M = Ca, Sr, Ba), $Sr_2 Ta_2 O_7^{[11]} \bigcup \bigcup A_2 La_2 Ti_3 O_9 (A = K, Rb, Cs)^{[12]},$ $ALaNb_2O_7(A=K,Rb,Cs)^{[13]},RbLnTa_2O_7(Ln=La)$ Pr、Nd、Sm)^[14]四元复合物等表现出光解水活性。这 些复合氧化物的结构特点是由 TaO₆、NbO₆、TiO₆ 八 面体以共棱或共角等形式构成了层板,而碱金属离子、 碱土金属离子等穿插在层间的钙钛矿型和类钙钛矿型 结构。在ABO。这种三元类钙钛矿型的复合物中,A 位阳离子相对于 B 位来说其对光催化性能的影响比较 小,因为导带和价带分别由 Bol 电子轨道和 O2p 电子 轨道决定。而在 RbLnTa2O7(Ln=La、Pr、Nd、Sm)等 四元复合物中, Ln 系元素未占据和部分占据的 4f 电 子轨道与 O2p 和 Ta5d 电子轨道的杂化对价带和导带 都有影响,从而影响其光催化性能[15]。部分铌酸盐、 钽酸盐、钛酸盐的制氢活性如表 1、2 所示[13~15]。

表1 部分铌酸盐的光解水产氢活性

Table 1 Photocatalytic activity for H₂ evolution of various niobates

	活性(µmol/h)					
催化剂						
	没有担戴	担载 Pt(0.1wt%)	6) 02"			
KLaNb ₂ O ₇	28	54	46			
RbLaNb ₂ O ₇	60	90	2			
CsLaNb ₂ O ₇	12	28	3			
KCa2 Nb3 O10	14	100	8			
RbCa2 Nb3 O10	3	26	16			
CsCa2 Nb3 O10	2	10	10			
KSr2 Nb3 O10	10	110	30			
KCa2 NaNb4 O13	5	280	39			

测试条件:催化剂 1.0g;450W 高压汞灯;*MeOH 50ml+ 300ml H₂O;^b0.01mol/L AgNO₃ aq.350ml。

在钛酸盐中,K₂ TiO₁₃、Na₂ Ti₆O₁₃以及 BaTi₄O₉等 属于网状结构,其表面有凹凸不平,均匀分布的纳米级 "雀巢"^[16~18]。Zou 等^[19]合成了一系列新的光催化材 料 Bi₂XNbO₇(X=Al、Ga、In、Y、稀土元素和 Fe)、Bi $MO_4(M = Nb^{5+}, Ta^{5+}), InMO_4(M = Nb^{5+}, Ta^{5+}), V^{5+}), 并且考察了其晶型结构、电子结构及其光解水$ 制氢活性。尽管这些催化剂有着不同的晶型结构,但它们都有一个共同的 TaO₆ 或者 NbO₆ 八面体,并且其能带结构的导带由 Ta、Nb 或 V 的 d 电子轨道决定,价带由 O2p 电子轨道决定。晶体结构中的 M—O—M的键角和键长是影响半导体光催化剂光物理和光催化性能的重要因素。其相对于 TiO₂ 光催化活性较低的原因是用通常的高温固相法合成的催化剂的比表面积很小(<1m²/g), m P25 的比表面在 50m²/g 左右。

表 2 部分钽酸盐和钛酸盐的光催化制氢活性 Table 2 Photocatalytic activity for H₂ evolution of various tantates and titanates

14 m m	活性(μ	mol/h)	14:11-41	活性(µmol/h)		
7111 16 71	H ₂	O ₂	7 74 76 70	H ₂	O ₂	
LiTaO ₃	6	2	CuTa ₂ O ₆	11	4	
NaTaO ₃	4	1	ZnTa ₂ O ₆	7	0	
KTaO₃	29	30	PbTa ₂ O ₆	3	0	
BaTa2 ()6	33	15	LaTaO ₄	6.9	2.5	
SrTa2O6	52	18	SrTiO ₃	微量	0	
CrTaO₄	2	0	Na2 Tis O13	微量	0	
MnTa ₂ O ₆	0.2	0	K2 Ti6 O13	微量	0	
CoTa ₂ O ₆	11	4	BaTi ₄ O ₁₉	微量	0	

测试条件:催化剂 1.0g 分散于 350ml 蒸馏水中;400W 高压 汞灯内部照射。

3.2 p区具有 d¹⁰构型的复合氧化物

从电子结构来看,处于 d 区的具有 d⁰ 电子构型的 复合物由于其全空的 d 层电子轨道有利于电子从 O2p 轨道跃迁至由 d 电子轨道确定的导带能级。对于 d 层 电子轨道全充满的 p 区复合氧化物的光催化活性也引 起了人们的研究兴趣。Sato 等^[20,21]考察了 铟酸盐 (In³⁺)、锡 酸 盐 (Sn⁴⁺)、锑 酸 盐 (Sb⁵⁺)、锗 酸 盐 (Ge⁴⁺)、镓酸盐 (Ga³⁺)等一系列 p 区具有 d¹⁰构型的 复合氧化物 (MIn₂O₄ (M = Ca、Sr)、NaInO₂、LaInO₃、 Sr₂SnO₄、M₂Sb₂O₇ (M = Ca、Sr)、CaSb₂O₆、NaSbO₃、 Zn₂GeO₄、ZnGa₂O₄等),揭示了这些复合物在表面负 载 RuO₂ 后 在紫外光下的 光解水 制 氢 活性,其中 Ca₂Sb₂O₇、Sr₂Sb₂O₇ 和 NaSbO₃ 在紫外光辐射下,可 以实现纯水的完全分解。该区的部分光催化剂的制氢 活性如表 3^[20,21]所示。

表 3 部分 p 区具有 d¹⁰ 电子构型的半导体光催化剂的 光催化产氢活性

Table 3 Photocatalytic activity for H_2 evolution of some photocatalys in p block with d¹⁰ configuration

/# /가 ===]	活性(µ	mol/h)	144 / 12 461	活性(µmol/h)		
ניול גאר שני	H ₂	O ₂	?¶≭1€i7N]	H ₂	O ₂	
NaSbO ₃	1.8	0.9	NaInO ₂	0.9	0.4	
CaSb ₂ O ₆	1.5	0.3	CaIn ₂ O ₄	13	5.5	
Ca ₂ Sb ₂ O ₇	2.4	1.1	SrIn ₂ O ₄	3.8	1.9	
Sr ₂ Sb ₂ O ₇	7.9	3.1	BaIn ₂ O ₄	做量	0	
ZnGa ₂ O ₄	9.0	3.5	Zn2GeO4	21	10	

测试条件:催化剂 1g 300ml 蒸馏水中;200W Hg-Xe 灯(248~· 643nm)內部照射;把載1%(质量分数)RuO₂。

1491

田蒙奎 等:光解水制氢半导体光催化材料的研究进展

在该系列复合物中,O2p电子轨道能级决定了价 带,导带则由 In、Sn 等原子的外层 SP 杂化轨道决定, 这和处于d区的复合氧化物的导带由d电子轨道决定 不一样,其原因是全充满的 d¹⁰电子轨道对电子从价带 的跃迁基本没有影响。由此形成的能级结构有助于光 生电子迁移,减少与空穴的复合。同时从晶型结构上 来看,其畸变的八面配位体 InO6、SnO6、SbO6、GaO6 或四面体 GeO,产生的内部偶极矩也有助于电子空穴 的分离,该特性对光催化活性起着重要作用。其中 Zn2GeO4 是目前唯一的具有光解水活性的具有四面体 配位 GeO, 的光催化剂^[21]。

d 区和 p 区体系的光催化剂集成图如图 2 所 示[21],该图显示了目前光催化剂材料研究领域的重点 考察区域。



图 2 d区和p区光催化剂集成图 Fig 2 Integration schematic diagram of d and p block photocatalys

3.3 层柱复合氧化物

在光催化领域,研究插层反应的目的是将主体和 客体的光学和电性质通过插层复合而进行修饰和改 性。由于层状材料具有二维的可膨胀的层间空间,插 层则意味着客体物质可逆地进入层状的主体材料中又 能保持主体材料的结构特点。插层化合物作为催化剂 及催化剂载体,具有选择性吸附、离子交换和光催化功 能,其基质材料为石墨,粘土矿物,层状的双氢氧化合 物,金属磷酸盐和膦酸盐以及过渡金属氧化物等。通 过插层后的复合物具有高比表面积,多孔结构且孔径 可调,具有酸中心并且可以通过层板和插层化合物的 调控来改变其电学性质和光催化活性等优点。通常插 层的步骤如下:

(1) 主体材料的制备,常采用固相反应;(2) 质子的交 换,层状的钙钛矿结构或蒙脱石结构层间的碱金属或 碱土金属离子被 H⁺ 取代;(3) 主体修饰,将质子交换 后的层状物移入含插层剂的液态溶液(一般为烷基胺, $C_n H_{2n+1} NH_2$, n=3~10), 在一定温度下搅拌, 过滤分 离,得到有机胺溶涨后的层状物;(4)插层反应:将需 要插入的客体物质(如 Al₂O₃、TiO₂、SiO₂、CdS、ZnS、 Fe₂O₃等)经不同的盐(柱化剂)离子交换插入后再通 过光沉积,锻烧等手段实现柱撑。

部分插层化合物与其预支撑有机胺以及柱化剂的 情况如表 4 所示[22]。Uchida 等[23] 合成了 HNbWO6/ Pt、HNbWO₆/(Pt、TiO₂)、HNbWO₆/Fe₂O₃和 HNb- $WO_{\epsilon}/(Pt_{Fe}O_{1})$,并发现其制氢活性比没有经过插 层的制氢活性大大提高,相同的现象也发现在 $H_2 Ti_4 O_9 - TiO_2$, $H_4 Nb_6 O_{17} - TiO_2$, $H_2 Ti_4 O_9 - Fe_2 O_3$ 和 H₄Nb₆O₁₇-Fe₂O₃体系中。Fujishiro^[24]等通过离子交 换、C₃H₇NH₂预胀,再与柱化剂[Fe₃(CH₃COO)₇OH. 2H₂O] + 和 [Pt (NH₃),] Cl₂ 离子交换制备了 $H_4 Nb_6 O_{17}/Cd_{1-x} Zn_x S$, $H_2 Ti_4 O_9/Cd_{1-x} Zn_x S$, $H_4 Nb_6 O_{17}/Cd_{1-x} Zn_x S$, $H_4 Nb_6 O_{17}/C$ $Fe_{H_2}Ti_4O_9/Fe_2O_3$, $H_4Nb_6O_{17}/(Pt_TiO_2)$, $H_2Ti_4O_9/(Pt_TiO_2)$ TiO₂)等层柱氧化物,柱撑后的氧化物的带隙比原客体 (host)的要稍大一些,但比由于粒子粒径减小引起的 量子效应产生的带隙增大要小。光催化制氢活性得到 强化的原因可能是光生电子由插入的半导体迁移到主 体材料的层板上,从而提高了电子空穴的分离。 Shangguan 等^[25,26]通过直接离子交换和硫化处理在层 状 Nb-Ti 复合氧化物中插入 CdS, 制备了 CdS/KTiNbO5、CdS/K2 Ti4 O9、CdS/K2 Ti3.9 Nb0.1 O9 等,并考察了 其光催化制氢性能。把光催化性能的提高归因于在插 入层间的 CdS 纳米粒子和层板间形成了紧密联接,从 层间的 CdS 上产生的光生电子能很快的迁移到层板 上的 TiO。和 NbO。 八面体上,从而有效的抑制了光生 电子与空穴的复合,实现了可见光诱导光解水制氢。 由于层柱支撑具有显著改善层状复合物的空间结构, 能显著提高其比表面积,通过与插层半导体化合物的 复合,能改善其光催化性能,是光解水光催化剂的研究 热点。

	表 4 部	分插层化合物	与其预支	撑有も	乳胺及其使用	的柱化	刑		
Table 4 Some lavered	d intercalation	i compounds a	s well as	their	pre-pillaring	organic	amines an	d pillaring	agents

桶层化合物	预支撑有机胺	柱化剂	昼间距(nm)(500℃)	
Al ₂ O ₃ -H ₂ Ti ₄ O ₉	正己胺	Al ⁷⁺	1.70	
Al ₂ O ₃ -HNb ₃ O ₈	正己胺	Al ⁷⁺	1.90	
Al ₂ O ₃ -H ₂ La ₂ Ti ₃ O ₁₀	正己胺	Al ⁷⁺	2.10	
SiO ₂ -H ₂ Ti ₃ O ₇	$C_n H_{2n+1} N H_2 (n=3 \sim 12)$	TEOS	1.04~294	
SiO ₂ -HNb ₃ O ₈	无	APS	1.30	
SiO ₂ -HLaNb ₂ O ₇	正己胺	APS	1.32	
TiO2-HLaNb2O7	正辛胺	TiO2 胶体	1. 13	
Fe ₂ O ₃ -H ₂ Ti ₄ O ₉	无	FeSO4 溶液	1.00	
ZrO_2 -HLaNb ₂ O ₇	正十六胺	$[Zr(OH)_{4-n}(H_2O)_{8+n}]^{n+}$	1.36	
Cr, O, -H, Ti, O,	正丙胺	Cr(OAc)	1.06	

注,其中 Al3+指的是含铝 Keggin 离子[Al3-Q, (OH)2, (H2O)2]⁺;TEOS 指的是四乙氧基硅烷;APS 指的是 NH2(CH2)3Si(OC,Q3)2.

2005 年第 10 期(36)卷

1492	3.0	12th	材	**
4 能在可见光下响应的光解水催化	剂			98.
在光解水制氢过程中,为了能利	可用占太阳	辐射中	[6]	Ogura S,Ko
47%的可见光,实现太阳能的高效转	化,追求能	也在可见		121/123.52
光区响应的光催化剂一直是光解水管	制氢的主要	研究目	[7]	Ogura S. H
标 不过遗憾的县就目前所研究开	发的光催化	k初中能		1994,8:233
	4下完全来		[8]	Ogura S, Sa
	日九王九	而可同	5 .7	2000,2.244
厂生 Π_2 州 U_2 的更少。比权有 $1\sqrt{4}$			[9]	Kudo A, T
尤的尤催化剂有 Zou 和 Ye 等	合成 NIU		57	111:67-76.
$O(473)$ 担载的 $In_{1-x}N_{1x}$ I a O_4 (x=0~	0.2),後指	主化剂能	[10]	Kudo A,
在可见光下完全光解水生成化学计	量比为 2:	1 BY H ₂	5117	2000,104
和 O ₂ ,在 402nm 下的量子效率达	到 0.66%	6. Hara	[11]	Kato H,
等 ^[29] 等通过把 Ta2O5、MTa2O7(M	=Ca,Sr,I	Ba)通以	[10]	569. K
NH ₃ 在 1123K 反应 15h 制得了 Ta	$ON(E_g = 2$	2.5eV)、	[12]	Konno IVI,
$Ta_3N_5(E_g=2.1eV)$ 和 MTaO ₂ N(M	1 = Ca, Sr,	Ba) (E_{g}	[19]	Vomenite
=2.5~2.0eV),它们在可见光下显;	示了很好的	り光解水	[13]	anice 200
性能。作者把其能带结构归因于导	带由 Ta 的	d 电子	[14]	Machida N
物道冲完,而价带由 N2n 由子物道:	冲完,由于	N2n 由	[14]	

轨道决定,而价带由 N2p 电子轨道决定,由于 N2p 电 子轨道的比 O2p 电子轨道位置更高一些,从而相对于 Ta₂O₅ 来说其带隙变窄了,因此能响应可见光。Asahi 等^[30]在 N₂(40%)/Ar 混和气氛下通过溅射法制备了 TiO_{2-x}N_x 薄膜,同时在 NH₃(67%)/Ar 混和气下合成 了 TiO_{2-x}N_x 粉体,它们都显示了很好的可见光吸收 性,能吸收<500nm 的可见光,包含了太阳辐射中可见 光区中最强的 480nm 左右的光。

5 结 语

目前的大多数光催化剂都面临同样的问题:(1) 能隙太宽,只能响应不足太阳能辐射5%的紫外光区, 相对太阳能中47%的可见光利用率很低;(2)价带和 导带的电位很难同时满足完全分解水的电位,需要如 CH₃OH、AgNO₃溶液等牺牲剂才能实现H₂或O₂的 产生;(3)光生电子空穴易复合,量子效率很低。由此 光催化光解水的研究方向或者研究重点是应该集中在 光响应范围宽和量子效率高的新型光催化剂的设计和 制备。这就要求研究者一方面要通过加强固体物理、 量子物理、半导体光电化学、材料学等学科的交叉,利 用量子计算等手段来指导新型光催化剂的创制,同时 采用先进的物理表征手段原位表征光照下所发生在催 化剂表面的微观物理和化学过程,以促进对光催化机 理的认识,从而寻求新的突破。

参考文献:

- [1] Fujishima A. Honda K. [J]. Nature, 1972, 238: 37-38.
- [2] Kawai T, Sakata T. [J], Nature, 1980, 286: 474-476.
- [3] Ashokkumar M. [J]. Int J Hydrogen Energy, 1998, 23: 427-431.
- [4]Mizoguchi H, Ueda K, Orita M, et al. [J]. Materials Research Bulletin, 2002, 37:2401-2406.
- [5] Domen K, Kudo A, Onishi T. [J]. J Catal, 1986, 102; 92-

[6]	Ogura S,Kohno M,Sato K, et al. [J]. Appl Surf Sci,1997,
	121/123:521-524.

- [7] Ogura S. Kohno M, Sato K, et al. [J]. J Mater Chem, 1994,8:2335-2337.
- [8] Ogura S, Sato K, Inoue K. [J]. Phys Chem Chem Phys, 2000,2:2449-2454.
- [9] Kudo A, Tanaka A, Domen K, et al. [J]. J Catal, 1998, 111:67-76.
- [10] Kudo A, Kato H, Nakagawa S. [J]. J Phys Chem B, 2000,104:571-575.
- [11] Kato H, Kudo A. [J], Catalysis Today, 2003, 78: 561-569.
- [12] Kohno M, Kaneko T, Ogura S, et al. [J], J Chem Soc Faraday Trans, 1998, 94:89-94.
- [13] Yamasita D, Takata T, Hara M, et al. [J]. Solid State Ionics, 2004, 172: 591-595.
- [14] Machida M, Yabunaka J, Kijima T, et al. [J]. International Journal of Inorganic Materials, 2001, 3, 545-550.
- [15] Kato H, Kudo A. [J]. Catalysis Today, 2003, 78: 561-569.
- [16] Shangguan W, Yashida A. [J]. Int J Hydrogen Energy, 1999,24:425-429.
- [17] Inoue Y, Kubokawa T, Sato K. [J]. J Phys Chem, 1991, 95:4059-4064.
- [18] Inoue Y. Asai Y. Sato K. [J]. Chem Soc Faraday Trans. 1994,90:797-802.
- [19] Zou Z G, Arakawa H. [J]. J Photochem Photobiol A, 2003,158:145-162.
- [20] Sato J, Saito S, Nishiyama H, et al. [J]. J Phys Chem, 2001,105,6061-6063.
- [21] Sato J, Kobayashi H, Ikarashi K, et al. [J]. J Phys Chem B, 2004, 108, 4369-4375.
- [22] 郭宪吉,侯文华,颜其洁,等.[J]. 科学通报,2002,47: 1681-1690.
- [23] Uchida S, Yamamoto Y, Sato T. [J]. J Chem Soc Faraday Trans, 1997, 93: 3229-3232.
- [24] Fujishiro Y, Uchida S, Sato T. [J]. Journal of Inorganic Materials, 1999, 1:67-72.
- [25] Shangguan W, Yoshida A. [J]. Solar Energy Materials & Solar Cells, 2001, 69: 189-194.
- [26] Shangguan W, Yoshida A. [J]. J Phys Chem B, 2002, 106:12227-12230.
- [27] Zou Z, Ye J, Sayama K, et al. [J]. Nature, 2001, 414; 625-627.
- [28] Zou Z, Ye J, Arakawa H J. [J]. Mater Res, 2002, 17: 1419-1423.
- [29] Yamasita D, Takata T, Hara M, et al. [J]. Solid State Ionics, 2004, 172, 591-595.
- [30] Asahi R, orikawa T, Ohwaki T, et al. [J]. Science, 2001, 293:269-271.

(下转第1500页)

1500		\$.17	1 th	财	\$ 4	2005 年第 10 期(36)卷
[25]	蒋维城.固体力学有限元分析[M].1	上京:北京:	理工大学		Acoustics, 1993	,115,103-110.
	出版社,1989.44.			[34]	Golla D F, Hug	nes P C. [J]. Journal of Applied Mechan-
[26]	胡卫兵,何 建.[J]. 西安建筑科技	大学学报	2002,34		ics,1985,52,89	7-907.
	(3):222-227.			[35]	邓年春,邹振祝	,黄文虎. [J]. 机械工程学报,2004,40
[27]	朱正佑,李根国,程昌钧.[J].应用数	学和力学	,2003,24		(3):128-132.	
-	(4):331-341.			[36]	石银明,华宏星	,李中付,等.[J]. 计算力学学报,2002,19

- [28] 刘天雄,华宏星,陈兆能,等.[J]. 机械工程学报,2002,38 (4):108-114.
- [29] 陈立群,程昌钧.[J].力学季刊,2001,22(4):512-516.
- [30] 李根国,朱正佑.[J].非线性动力学学报,2001,8(1):19-26.
- [31] 朱正佑,李根国,程昌钧.[J].应用数学和力学,2002,23 (1):1-10.
- [32] 刘天雄,华宏星,陈兆能.[J]. 航空学报,2002,23(2): 143-146.
- [33] McTavish D J, Hughes P C. [J]. Journal of Vibration and

- (1).99-104.
- [37] 刘天雄,华宏星,石银明,等.[J].工程力学,2002,19(6): 98-104.
- [38] 刘天雄,石银明,华宏星,等.[J]. 机械强度,2002,24(1): 23-28.
- 刘天雄,华宏星,陈兆能.[J]. 航空学报,2002,23(2): [39] 143-146.
- [40] 邓年春,邹振祝,杜华军,等.[J].振动工程学报,2003,16 (4):489-492.

Review of models about material damping

XIONG Wei, LIU Yao-zong, QIU Jing, YU Dian-long

(Institute of Mechatronical Engineering, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China) Abstract: Several models about material damping, especially the models about viscoelastic material, were reviewed. The characteristics of these models and the applications were summarized.

Key words: damping model; viscoelastic; material damping

(上接第1492页)

Progress of semiconductor materials as photocatalysts for hydrogen production from water decomposition

TIAN Meng-kui^{1,2}, SHANGGUAN Wen-feng², OUYANG Zi-yuan¹, WANG Shi-jie¹

(1. Geochemistry Institute of Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550002, China;

2. Research Center for Combustion and Environmental Technology, School of Mechanical and Power Engineering, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China)

Abstract: Since the pioneering work of Fujishima and Honda, many scientists have focused on the direct conversion of solar energy into storable and clean chemical energy, hydrogen, by a photocatalytic reaction using some semiconductor. This paper describes the progress in the last decade for the photocatalytic decomposition of water into hydrogen and oxygen. The main focus was to provide some information on photocatalytic properties of TiO₂, transition metal oxides, complex metal oxides, layered metal oxides and some new photocatalysts that can decompose water in visible light. The opinions on further studies are also presented in this paper.

Key words: water decomposition; hydrogen energy; semiconductor photocatalyst

(上接第1496页)

Progress of thermoelectric nanomaterials and its preparation by ECALE

GAO Xian-hui, YANG Jun-you, ZHU Wen, HOU Jie

(State Key Laboratory of Die& Mould Technology, Huazhong Univ. of Sci. & Tech, Wuhan 430074, China) Abstract: The developing status of thermoelectric materials was reviewed and the mechanism for nanostructured thermoelectric materials to enhance the figure of merit was discussed in this paper. A new methord named as electrochemical atomic layer epitaxy (ECALE), which uses underpotentional deposition (UPD) to restrict 3D growth and realize 2D growth, was introduced and discussed for preparation of thin film and superlattice. At last, some vital factors involved in ECALE were pointed out and the developing trends of thermoelectric materials and device were summarized.

Key words: nanostructured thermoelectric materials; ECALE; UPD